








	<h2>SI4214DDY-T1-E3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI4214DDY-T1-E3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8SO</p> <p>Datenblätter:  SI4214DDY-T1-E3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 43198 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI4214DDY-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8SO
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	43198 pcs Stock
detaillierte Beschreibung	Mosfet Array 2 N-Channel (Dual) 30V 8.5A 3.1W
Serie	TrenchFET®
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Leistung - max	3.1W
Verpackung / Gehäuse	8-SOIC (0.154", 3.90mm Width)
Supplier Device-Gehäuse	8-SO
Typ FET	2 N-Channel (Dual)
FET-Merkmal	Logic Level Gate
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	8.5A
Rds On (Max) @ Id, Vgs	19.5 mOhm @ 8A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	22nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	660pF @ 15V
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)

SI4214DDY-T1-E3 ist neu im Original, Suche SI4214DDY-T1-E3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI4214DDY-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI4214DDY-T1-E3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI4214DDY-T1 VISHAY VISHAY SO-8</p>	 <p>SI4214DY-T1-E3 VISHAY SI4214DY-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SI4214DDY-T1-E3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8SO</p>	 <p>SI4212-TRDX-EVB Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL DAUGHT CARD FOR SI4212</p>
 <p>SI4214DDY-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>	 <p>SI4212-TKDX-EVB Energy Micro (Silicon Labs) KIT EVAL TXRX FOR SI4212</p>	 <p>SI4214DDY-T1 VISHAY SI4214DDY-T1 VISHAY</p>	 <p>SI4214DDY-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET 2N-CH 30V 8.5A 8-SOIC</p>

heiße Teile

Mehr

SI4200-BM	SI4200-BMR	SI4200-GM	SI4200-GMR	SI4200BM
SI4200DB-BMR	SI4200DY-T1-E3	SI4201-BMR	SI4201-GMR	SI4202DY
SI4205-BM	SI4205-BMR	SI4206-BM	SI4206-BMR	SI4208-A-GMR
SI4208GM	SI4209-A-GMR	SI4210-C-GMR	SI4210-D-GMR	SI4210-GM
SI4210DY-T1-E3	SI4210DY-T1-GE3	SI4210DY-T1-GE3	SI4210GM	SI4214DDY
SI4214DDY-T1-E3	SI4214DDY-T1-GE3	SI4214DDY-T1-GE3	SI4214DY-T1-E3	SI4214DY-T1-GE3
SI4214DY-T1-GE3	SI4220-GM	SI4226DY	SI4226DY-T1-E3	SI4226DY-T1-E3
SI4226DY-T1-GE3	SI4226DY-T1-GE3	SI4228DY	SI4228DY-T1-E3	SI4228DY-T1-E3
SI4228DY-T1-GE3	SI4228DY-T1-GE3	SI4232DY	SI4276DY-T1-E3	SI4276DY-T1-E3
SI4282DVP	SI4286DY	SI4286DY-T1-GE3	SI4286DY-T1-GE3	SI4288DY

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited